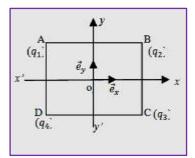
Filière: SMPC – SMIA (S2)

TRAVAUX DIRIGES Correction de la série N° 2 - ELECTRICITE 1

Exercice N°1

On place quatre charges ponctuelles aux sommets ABCD d'un carré de côté a =1 m, et de centre O, origine d'un repère orthonormé Oxy de vecteurs unitaires \vec{e}_x et \vec{e}_y . On donne : $q_1=q=10^{-8}$ C, $q_2=-2q$, $q_3=2q$, $q_4=-q$.

- 1- Déterminer le champ électrostatique $\vec{E}(0)$ créé par la distribution au centre 0 du carré. Préciser la direction, le sens et la norme de $\vec{E}(0)$.
- 2- Exprimer le potentiel électrostatique V(0) créé en 0 par les quatre charges.



Correction de l'exercice N°1

1- Détermination du champ E en O.

Soit E_1 , E_2 , E_3 et E_4 les champs créés en O respectivement par les charges q_1 q_2 , q_3 q_4 .

D'après le principe de superposition, on écrit :

$$\vec{E} = \vec{E_1} + \vec{E_2} + \vec{E_3} + \vec{E_4}$$

Par raison de symétrie :

$$\overrightarrow{E_1} + \overrightarrow{E_4} = -2 E_1 \cos \frac{\pi}{4} \quad \overrightarrow{e_y} = -2 k \frac{2q}{a^2} \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \overrightarrow{e_y}$$
$$= -\frac{2kq}{a^2} \sqrt{2} \quad \overrightarrow{e_y}$$

On a de même:

$$\overrightarrow{E_2} + \overrightarrow{E_3} = 2 E_2 \cos \frac{\pi}{4} \quad \overrightarrow{e_y} = 2 k \frac{4q}{a^2} \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \overrightarrow{e_y}$$
$$= 4k \frac{q}{a^2} \sqrt{2} \quad \overrightarrow{e_y}$$

Soit:
$$\vec{E} = \frac{2k q}{a^2} \sqrt{2} \vec{e_y}$$

Le champ résultant \vec{E} est donc :

- dirigé suivant l'axe y'Oy;
- dans le sens positif de l'axe y'Oy;

- de norme
$$E = \frac{2k q}{a^2} \sqrt{2}$$

A N:
$$E = 9 \times 10^9 \times 10^{-8} \ 2\sqrt{2} = 254,6 \ V/m$$

2- Détermination du potentiel V en 0 :

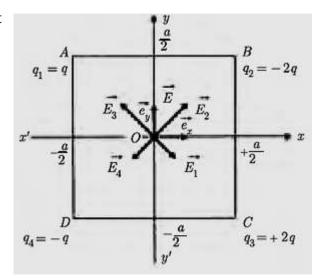
Soient V_1 ; V_2 ; V_3 et V_4 les potentiels créés par les charges q_1 ; q_2 ; q_3 et q_4 en O.

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = k \left(\frac{q}{OA} - \frac{2q}{OB} + \frac{2q}{OC} - \frac{q}{OD} \right)$$

$$OA = OB = OC = OD = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = \frac{\sqrt{2}k \ q}{a} (1 - 2 + 2 - 1)$$

Soit: V = 0

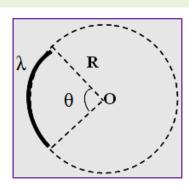


Filière: SMPC – SMIA (S2)

Exercice N°2

Soit une quantité de charge Q répartie sur une portion d'une circonférence de centre O et de rayon R = 5cm, de densité linéique $\lambda = 10^{-13}$ C/cm (λ <0). La portion à une longueur R θ ($\theta = \pi/3$).

- 1- Donner l'expression du champ électrostatique élémentaire $d\vec{E}$ créé par la densité de charge élémentaire dQ au centre O. Donner d'abord dQ en fonction de λ , R et $d\theta$.
- 2- En déduire le champ \vec{E} créé par la charge Q au point O.
- 3- Calculer le module de \overrightarrow{E} .



Correction de l'exercice N°2

1- L'expression du champ électrostatique élémentaire $d\vec{E}$ créé par la densité de charge élémentaire dQ au centre Q.

On donner d'abord dQ en fonction de λ , R et d θ .

$$dQ = \lambda \, dl = \lambda \, R \, d\theta$$

$$d\vec{E} = \frac{dQ}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\overrightarrow{PO}}{\left\|\overrightarrow{PO}\right\|^3} = \frac{\lambda \, dl}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\left(-R \, \overrightarrow{e_r}\right)}{R^3}$$

Or $dl = R d\theta$

Donc:
$$d\vec{E} = \frac{-\lambda d\theta}{4\pi\varepsilon_0 R} \vec{e_r}$$

2- le vecteur $\vec{e_r}$ est variable, il faut le projeter sur la base $(\vec{\iota}, \vec{j})$

$$\overrightarrow{e_r} = \cos\alpha \ \overrightarrow{i} + \sin\alpha \overrightarrow{j}$$
 et $d\theta = d\alpha$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R} \int_{\pi-\frac{\theta}{2}}^{\pi+\frac{\theta}{2}} \left(\cos\alpha \vec{i} + \sin\alpha \vec{j}\right) d\alpha = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R} \left[\sin\alpha \vec{i} - \cos\alpha \vec{j}\right]_{\pi-\frac{\theta}{2}}^{\pi+\frac{\theta}{2}} = -\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R} \left[-2\sin\frac{\theta}{2} \vec{i} + 0\vec{j}\right]$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R} 2\sin\frac{\theta}{2} \vec{i}$$

3- Calcul du module de \overrightarrow{E}

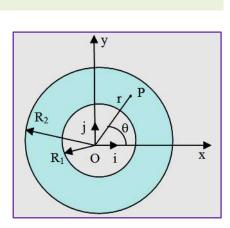
$$E = \frac{2|\lambda|\sin\frac{\theta}{2}}{4\pi\varepsilon_0 R} \qquad \text{avec} \quad \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\ 10^9\ (SI) \qquad |\lambda| = 10^{-11}\ C/m$$

$$E = \frac{210^{-11} \cdot \frac{1}{2} \cdot 9\ 10^9}{5 \cdot 10^{-2}} = 1.8\ V/m$$

Exercice N°3

Une surface plane, limitée par deux cercles de centre O (disque creux) et de rayons R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$) porte une charge électrique Q uniformément répartie sur sa surface. Soit ds un élément de surface de la couronne, dont le centre P est repéré par ces coordonnées polaires r et θ (voir figure ci-contre)

- 1- Exprimer la densité de charges (du disque creux) σ en fonction de Q, R_1 et R_2 .
- 2- Donner l'expression du champ électrostatique élémentaire $d\vec{E}(M)$ crée par l'élément ds en un point M (d'ordonnée z) de l'axe Z'OZ perpendiculaire au plan de la couronne.
- 3- Donner l'expression de ds dans le système de coordonnées polaires et exprimer le vecteur \overrightarrow{PM} dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
- 4- Déduire l'expression du champ $\vec{E}(M)$ créé par le disque creux au point M. En déduire le champ $\vec{E}(O)$ au point O.



Filière: SMPC – SMIA (S2)

5- Déduire l'expression du champ $\vec{E}(M)$ créé par un plan infini uniformément chargé avec une densité de charges σ . Ce champ est-il défini sur le plan ?

Correction de l'exercice N°3

Astribution uniform
$$ED = CTE = \frac{G}{5}$$

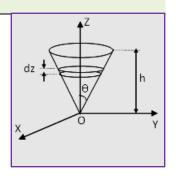
over $S = S_{R_2} - S_{R_3} = TT(R_2 - R_3^2)$
 $ED = \frac{G}{TT(R_2^1 - R_3^2)}$
 ED

Exercice N°4

Filière: SMPC – SMIA (S2)

A- Soit un disque de centre O, d'axe OZ, de rayon R, placé dans le plan XOY. Ce disque est chargé uniformément avec une densité surfacique de charge σ >0.

- 1- Déterminer le potentiel V(M) créé par cette distribution de charges en un point M de l'axe du disque tel que OM = z.
- 2- Déterminer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ au point M de l'axe OZ.
- B- Soit un cône d'axe OZ, de hauteur h, de demi-angle au sommet θ et dont le sommet coïncide avec l'origine du repère OXYZ (figure ci-contre). Ce cône est chargé uniformément en volume avec la densité ρ .



- 1- Déterminer le champ électrostatique $d\vec{E}$ créé au point 0 par une tranche du cône d'épaisseur dz.
- 2- En déduire le champ \vec{E} créé par l'ensemble de la distribution volumique au point 0.

Correction de l'exercice N°4

Al10/ Détermination du potentiel V(M) 27

Le prévatiel élémentoire unée ent par une shange de en l' (Noir ligray) 0

dV = 1/4 pm vir de = r deplur

Le potentiel une en m par une consonne sir culoire élémentoire de vayon v; dépos éseur du 3to dV = 1/4 pm control ve de vayon v; dépos éseur du 3to dV = 1/4 pm control (3t+v2)-1/2

Le potentul uneé en m par le disque utragé de vayon R?

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 v dr

V(M) = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-2 = 5/4 pm 20 fr dr (32+v2)-

over la valeur négatives de z.

Filière: SMPC – SMIA (S2)

29/ Le shamp electrostatique E(H) =

Los change élémentaire localises en P contenue dans un élément de surface des = v de obve en é au point M situé en l'ace oz le change élémentaire : dÉ = dq PM = ordr de PM PM - une pM² PM

Une convonne siraloire élimentoire de voyon v et d'époisseur du , sué

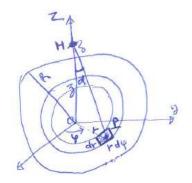
en M le charge: $\vec{dE}_{con} = \frac{\sigma}{4\pi \epsilon_{pM}^2} \frac{\vec{p}_{M}}{\vec{p}_{M}}$

The projection de le shorp sur l'axe OZ:

HAZ $d\vec{E}_{con} \cdot \vec{e_{z}} = \frac{G 2\Pi V dV}{I_{HII} E PH^{2}} \cdot \vec{e_{z}}$ $= \frac{G V dV}{2 E_{0} \left(V^{2} + \vec{g}^{2}\right)} \cdot Los \lambda = \frac{G V dV}{2 E_{0} \left(V^{2} + \vec{g}^{2}\right)} \cdot V^{2} \cdot \vec{e_{z}}$ $RH = \left(3^{2} + V^{2}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot dt \quad \lambda = \left(HO, HP\right)$

La charp ense par tout le disque our point M s'abtret parintegration à

$$\Xi(H) = \frac{\sigma_3}{2z} \int_0^R \frac{v \, dv}{(v^2 + 3^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sigma}{2z} \left[\frac{3}{151} - \frac{3}{(\kappa^2 + 3^2)^{\frac{3}{2}}} \right]$$



BJ-10/ Determination du champ de créé au point d'a

La transhe d'époissent de pad être animilée à un dissupre changé once une densité surfocique or qui s'exprime en fortron de e en utilisant la consensation de la Chinge iloctrique de la Transhe 3 or S = o Tr2 = e dv = e Tv2 de

IN o=edz.

Filière: SMPC – SMIA (S2)

D'acte pant; si z st Pobacisse du certre de la tranche, Pabacisse de 8 par voppart à ce contre est -3.

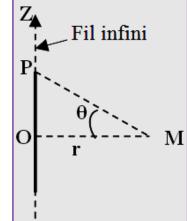
Done; l'expression du charpe electrostatique d'E eric pan la Tranche Lonsiderei, Nabtient à partir de celle du charpe ensité por un disape (question A-2) ou rample sont o par edz et 3 pan -3: $dE = \frac{e dz}{2E} \left[\frac{-3}{131} - \frac{3}{\sqrt{R^2 + 3^2}} \right] R = \frac{e dz}{2E} \left[-1 + \cos \theta \right] R$ Ser 3 est positif.

20/ Le charpe total E erele por l'en semble de la distribution de charges du kône s'obtient en intégrant l'en pression et d'E semble 3 variont entre o et h à $E = \int_0^{\infty} \frac{e}{2E} \left(\cos \theta - 1 \right) R = \frac{1}{2E}$

Exercice N°5

On considère un fil infini, confondu avec l'axe OZ, chargé uniformément avec une densité de charges linéique λ (λ > 0).

- 1- Par des considérations de symétrie et d'invariance (qui seront clairement explicitées), déterminer la direction du champ électrostatique \vec{E} et la variable dont il dépend.
- 2- Soit un point **P** sur le fil, à l'altitude z, et un point M de l'espace, tel que OM = r (voir figure ci-contre). Un petit élément $d\ell$ centré au point P contenant la charge élémentaire **dq**, créé au point M un champ électrostatique élémentaire \vec{E} . Déterminer le champ élémentaire $d\vec{E}$.
- 3- En déduire le champ électrostatique \vec{E} total crée par le fil au point M.
- 4- Retrouver ce résultat par application du théorème de Gauss en justifiant le choix de la surface de Gauss.
- 5- En déduire le potentiel V(M). On donne V(r=1)=0.
- 6- Sans faire de calcul, donner la forme des lignes de champ et celle des surfaces équipotentielles.



Correction de l'exercice N°5

Filière: SMPC – SMIA (S2)

10/ - Sour un point M quel conque de l'espace;

← Fil imfimi

la diste per pendi culoire au fif et passant par le

point Mast un axe de symétrie; le shamp électrique E(M) et donc posté por set axe. Il et orthorodial (porté par et : verteur unitaire en casadonnes sylindriques).

- D'autre part, une translation le long de l'axe 0Z, on une retation autour de l'axe 0Z loissent la distribution inchangée. Lear montre donc que le champ électroque E me dépend mi de Z mi de P et me dépend donc que de P : È = E(r) èp

Fil imfimi

20/ d= = dq (PH) = 1 dz w

over = dq = Ade = Ade ; II = PH = coso = - simpez.

Z= r. +g8 =D dz = V do

A COSO = 1 = PM2 = 12 .

d'où

de = Ado (cosoer - simoer)

Filière: SMPC - SMIA (S2)

39/ D'opus la question 19/ Seule la composante de É suivant

er est mon mulle. Le shamp électrostotique total serie par

+ out le fil et 8

E = $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon} r \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\cos\theta \, \epsilon_r - \sin\theta \, \epsilon_r^2) \, d\theta$ = $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon} r \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\cos\theta \, \epsilon_r^2 - \frac{\lambda}{4\pi\epsilon} r \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sin\theta \, d\theta \, \epsilon_r^2$

dish E = 1 TEr

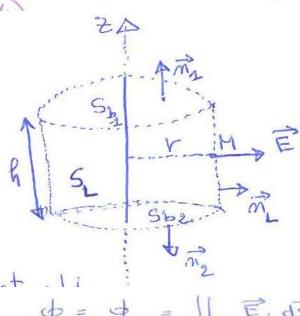
et de ragon r.

4% - La distribution prossède une symétric ly lindrique; la surface de Gouss & adéquate est 25 donc un ly lindre fermé de longueur h si 52 1

- L'application du Théorème de bourss à sette Surface mons donné le flux du changélectrostique à traves cette surface formée somme =

φ = φ = + φ + φ = +

- Por la surfaces de borse, le shorp et la vecters senfoca mormula Sortantes sont orthogonaux, donc le flex et mel, d'où à



 $\phi = \phi_{sL} = \iint_{SL} \vec{E} \cdot d\vec{s} = E(r) \vec{p} = E(r) 2\pi r h = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$ $= \frac{\lambda n}{\epsilon}$

d'on = - X .Er

Filière: SMPC – SMIA (S2)

Safe

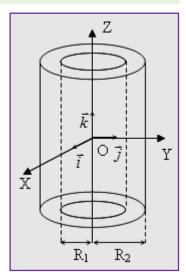
Sol Le potential
$$V(H)$$
 au point H st determine en atilisent la V -clation: $E(H) = -g \operatorname{rod} V(H)$

$$E = \frac{1}{2\pi E r} = -g \operatorname{rod} V = -\left(\frac{\partial V}{\partial r} = r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial r} = \frac{\partial V}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial r$$

Exercice N°6

Considérons deux cylindres C_1 et C_2 de même axe OZ, de rayons respectifs R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$) et de hauteur infinie. Les deux cylindres sont chargés uniformément en surface avec les densités surfaciques de charges respectifs σ_1 et σ_2 .

- 1- En utilisant la notion de symétrie de charges, déterminer la direction du champ $\vec{E}(M)$ crée par les deux cylindres en un point M de l'espace.
- 2- En utilisant la notion des invariances, montrer que le champ $\vec{E}(M)$ ne dépend que de la distance $r = \|\overrightarrow{OM}\|$?
- 3- Quelle est la surface de Gauss convenable à cette distribution de charges? Justifiez votre réponse.
- 4- En appliquant le théorème de Gauss, déterminer le champ $\vec{E}(M)$ crée par les deux cylindres en tout point M de l'espace.
- 5- En déduire le potentiel V(M) en tout point M de l'espace. (On prendra comme origine des potentiels (V(0) = 0)).



Filière : SMPC – SMIA (S2)

1º/ La symitrie et cylindrique (I, 4,3) -> les plans IT (M, R, et)

et IT (M, et, eq) nont deux plans de symitrie de la

distribution changée (des cylindre) contenent M

EC INIT -> Est porté par et.

20/ \$5: on fait une translation de la distribution (2 cylindus)
Suivant l'axe 08 (c-o-d z varie); la distribution
reste in variante per rapport à M

- Même share pour la rotation autour de 03 (cool 4 unie)

 Dla distribution reste invorvante par rapport à M
 - Por sontre si on foit une translation des 2 suy lindres Suivant ér (coid 22 Monie); alors la distribution de shorges shonge pour rapport à M (n'approche ou s'éloigne de M).

=> E dépend de x.

Done $\vec{E}(M) = E(K)\vec{e}_{k}$ Notion de symétrie Notion d'Invariance

30/ la symithie est sylindrique donc la surface de Gouss le plus adoptée à cette distribution de changes est un cy lindre de même axe que les danx cy lindres changes et de ray on re et de hauteur h.

Filière: SMPC – SMIA (S2)

Theorems do Gown:
$$f_{Sunf} = G_{int}$$

Theorems do Gown: $f_{Sunf} = G_{int}$

Theorems do $f_{Sunf} = G_{$

V3 = - (0, R1 + 02 R2) ln r + C3

Filière: SMPC – SMIA (S2)

Differentiation de constants
$$C_2$$
: C_2 et C_3 or C_3 and C_4 and C_4 and C_5 and C_6 and C_7 and C_8 and

Exercice N°7

Considérons deux sphères S_1 et S_2 de même centre 0 et de rayons respectifs R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$). La sphère interne S_1 est chargée uniformément en volume avec une densité volumique de charges ρ et la sphère externe S_2 est chargée uniformément en surface avec une densité surfacique de charge σ .

- 1- En utilisant la symétrie de charges, déterminer la direction du champ $\vec{E}(M)$ créé par les deux sphères en un point M de l'espace ?
- 2- En utilisant la notion d'invariance, déterminer les variables dont dépend le champ $\vec{E}(M)$.
- 3- Quelle est la surface de Gauss adaptée à cette distribution de charges ?
- 4- En appliquant le théorème de Gauss, déterminer le champ $\vec{E}(M)$ crée par les deux sphères en tout point M(r) de l'espace.
- 5- Déterminer le potentiel V(M) en tout point de l'espace. $(V(\infty)=0)$.

Correction de l'exercice N°7

1º/ an a une symithie opherique, donc an va Trousiller dans
le système de condonnés ophériques

le plan (M, Er, E) st un plan de symithie de la distribution
de changes Lonsidevec, donc E(M) & plan (M, Er, E).

de même pour le plan (M, Er, Ele); donc .

E e n de deux plans

E e n de deux plans

Filière: SMPC - SMIA (S2)

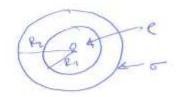
29/-50 on fit une rotation des dont optives suivant o on 4 ; lon distribution de Changes neste inchangé pur repport ou point M(r).

- Par contre sion foit une translation si unt 32, la distribution change = \[\E = E(r) \vec{e}_r \].

3º la symétrie est ophérique donc la senface de Granss adaptée est une ophére de même contre que les dons ophères changes et de rayon se.

4º/ 1200 3 r (R1

la surface de bours est la sphère de contre or et de voyon et.



Puinque E me de pard que de x, donc:

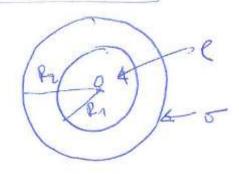
of M e aphère de Cours E(v) = cte.

Finds = Pint ; Pint = Change totale qui se transe à l'interieur de la surface fer mei de Gans

E_ = E_ (v) =, ds = ds =v

=> \$= E 4\Pi 12 = \frac{4}{3} \frac{\pi \in \text{2}}{50} e ; (QiM = e \frac{1}{3} \pi \text{17} \text{18})

=> \$\pi = \frac{1}{3} \frac{\pi \in \text{17}}{50} e ; (QiM = e \frac{1}{3} \pi \text{17} \text{18})



* 2 coss RaCV CRES

ф=Е 4П V2 = 4 П R3 . е ; (Uint = e 4 П R3)

Filière: SMPC – SMIA (S2)